

产品目录

车载用IC

2023

(存储器、磁性传感器IC、放大器(模拟IC)、定时器IC)



特点	系列	页
车载用串行E²PROM (SPI, I²C, Microwire)		
车载用工作温度150°C 3线串行E ² PROM	S-93S46A/56A/66A	9-3
车载用工作温度125°C 3线串行E ² PROM	S-93A46B/56B/66B/76B/86B	9-3
车载用工作温度105°C 3线串行E ² PROM	S-93C46C/56C/66C/76C/86C H系列	9-4
车载用工作温度125°C SPI 串行E ² PROM	S-25A010A/020A/040A	9-4
车载用工作温度125°C SPI 串行E ² PROM	S-25A080A/160A/320A, S-25A080B/160B/320B	9-5
车载用工作温度125°C SPI 串行E ² PROM	S-25A640A, S-25A640B	9-5
车载用工作温度125°C SPI 串行E ² PROM	S-25A128B	9-6
车载用工作温度125°C SPI 串行E ² PROM	S-25A256B	9-6
车载用工作温度105°C SPI 串行E ² PROM	S-25C010A/020A/040A H系列	9-7
车载用工作温度105°C SPI 串行E ² PROM	S-25C080A H系列	9-7
车载用工作温度105°C SPI 串行E ² PROM	S-25C160A H系列	9-8
车载用工作温度105°C SPI 串行E ² PROM	S-25C320A/640A H系列	9-8
车载用工作温度105°C SPI 串行E ² PROM	S-25C128A H系列	9-9
车载用工作温度105°C 2线串行E ² PROM	S-24CS01A/02A/04A H系列	9-9
车载用工作温度105°C 2线串行E ² PROM	S-24C08C H系列	9-10
车载用工作温度105°C 2线串行E ² PROM	S-24C16C H系列	9-10
车载用工作温度105°C 2线串行E ² PROM	S-24C32C/64C H系列	9-11
车载用工作温度105°C 2线串行E ² PROM	S-24C128C H系列	9-11

特点	系列	页
车载用磁性传感器 (霍尔效应IC)		
车载用、工作温度150°C、高耐压、高速、两极检测型 霍尔效应开关IC	S-57GD S系列	9-12
车载用、工作温度150°C、高耐压、高速、单极检测型 霍尔开关IC	S-57GS/57GN S系列	9-12
车载用 工作温度125°C 高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC	S-57A1 A系列	9-13
车载用、工作温度150°C、高耐压、高速、Zero Crossing Latch霍尔效应IC	S-57TZ S系列	9-13
车载用、工作温度150°C、高耐压、高速、交变检测型 霍尔效应IC	S-57RB S系列	9-14
车载用 工作温度150°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC	S-57P1 S系列	9-14
车载用 工作温度125°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC	S-57K1 A系列	9-15
车载用运算放大器		
车载用、工作温度125°C 2电路 CMOS运算放大器	S-19610A	9-16
车载用、工作温度105°C、2电路 低输入失调电压的CMOS运算放大器	S-19611A	9-16
车载用、工作温度125°C、2电路 低输入失调电压的CMOS运算放大器	S-19630A	9-16
车载用实时时钟		
车载用 工作温度105°C 3线 实时时钟	S-35190A H系列	9-17
车载用 工作温度105°C 2线 实时时钟	S-35390A H系列	9-17
车载用便利型定时器		
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、内置水晶振子的2线定时器	S-35710M A系列	9-18
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、2线定时器	S-35710 A系列	9-18
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、带中断时间设定端子的定时器	S-35720 A系列	9-18
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、有时钟脉冲输出功能、带频率设定端子的定时器	S-35730 A系列	9-18
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、2线间隔定时器	S-35740 A系列	9-19
便利型定时器 车载用、工作温度125°C、2线计数器	S-35770 A系列	9-19
CMOS IC封装		
封装一览表		9-20

S-93S46A/56A/66A

车载用工作温度150°C
3线串行E²PROM

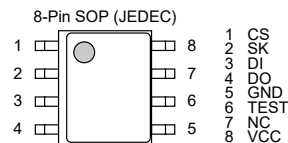
● 特点

- 工作电压范围
 - 读出时: 4.0 V ~ 5.5 V (Ta = -40°C ~ +150°C)
 - 写入时: 4.0 V ~ 5.5 V (Ta = -40°C ~ +150°C)
- 工作频率: 1 MHz
- 写入时间: 4.5 V ~ 5.5 V (Ta = -40°C ~ +150°C) 10.0 ms (最大值)
- 可以连续读出
- 电源电压低时禁止写入功能
- 指令误识别的防止写入功能
- CMOS施密特输入 (CS, SK)
- 重写次数*1: 2 × 10⁵次 / 字*2 (Ta = +150°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +125°C)
20年 (Ta = +150°C)
- 存储器容量
 - S-93S46A: 1 K位
 - S-93S56A: 2 K位
 - S-93S66A: 4 K位
- 首次出厂时数据: FFFFh
- 老化测试规格: 晶圆级老化测试
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +150°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*3

*1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。

*2. 每个地址 (字: 16位)

*3. 详情请与代理商联系。



S-93A46B/56B/66B/76B/86B

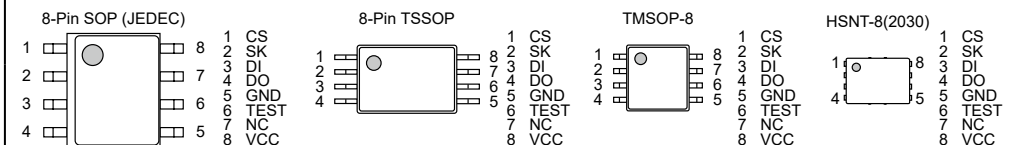
车载用工作温度125°C
3线串行E²PROM

● 特点

- 存储器容量
 - S-93A46B: 1 K位 (64字 × 16位)
 - S-93A56B: 2 K位 (128字 × 16位)
 - S-93A66B: 4 K位 (256字 × 16位)
 - S-93A76B: 8 K位 (512字 × 16位)
 - S-93A86B: 16 K位 (1024字 × 16位)
- 工作电压范围
 - 读出时: 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 2.0 MHz (最大值)
- 写入时间: 4.0 ms (最大值)
- 顺序读出功能
- CMOS施密特输入 (CS, SK, DI)
- 电源电压低时禁止写入功能
- 指令误识别的防止写入功能
- 重写次数: 10⁶次 / 字*1 (Ta = +85°C)
8 × 10⁵次 / 字*1 (Ta = +105°C)
5 × 10⁵次 / 字*1 (Ta = +125°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +125°C)
- 首次出厂时数据: FFFFh
- 晶圆级老化测试 (标准规格)
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*2

*1. 每个地址 (字: 16位)

*2. 详情请与代理商联系。



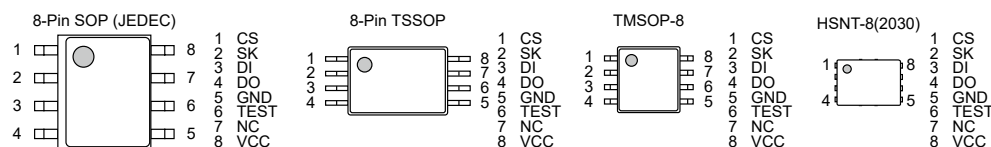
S-93C46C/56C/66C/76C/86C H系列

车载用工作温度105°C
3线串行E²PROM

● 特点

- 存储器容量
 - S-93C46C : 1 K位 (64字 × 16位)
 - S-93C56C : 2 K位 (128字 × 16位)
 - S-93C66C : 4 K位 (256字 × 16位)
 - S-93C76C : 8 K位 (512字 × 16位)
 - S-93C86C : 16 K位 (1024字 × 16位)
- 工作电压范围
 - 读出时 : 1.6 V ~ 5.5 V
 - 写入时 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 2.0 MHz (最大值)
- 写入时间 : 4.0 ms (最大值)
- 顺序读出功能
- 电源电压低时禁止写入功能
- 指令误识别的防止写入功能
- 重写次数 : 10⁶次 / 字^{*1} (Ta = +85°C)
8 × 10⁵次 / 字^{*1} (Ta = +105°C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +105°C)
- 首次出厂时数据 : FFFFh
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +105°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

- *1. 每个地址 (字 : 16位)
*2. 详情请与代理商联系。



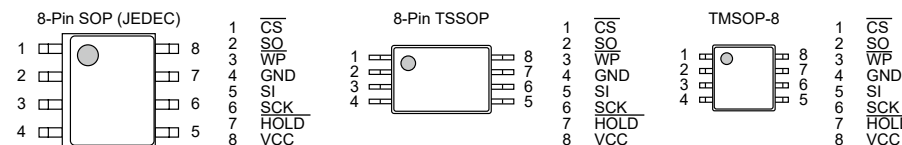
S-25A010A/020A/040A

车载用 工作温度125°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围
 - 读出时 : 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时 : 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率 : 6.5 MHz (最大值)
- 写入时间 : 4.0 ms (最大值)
- 支持 SPI 模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能 : 16 节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能 : 软件、硬件
保护领域 : 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS 施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数^{*1} : 10⁶次 / 字^{*2} (Ta = +25°C)
5 × 10⁵次 / 字^{*2} (Ta = +125°C)
- 数据保存期 : 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +125°C)
- 存储器容量
 - S-25A010A : 1 K位
 - S-25A020A : 2 K位
 - S-25A040A : 4 K位
- 首次出厂时数据 : FFh, BP1 = 0, BP0 = 0
- 老化测试规格 : 晶元级老化测试
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*3}
- 应对 AEC-Q100 标准^{*4}

- *1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。
*2. 每个地址 (字 : 8位)
*3. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。
*4. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25A080A/160A/320A, S-25A080B/160B/320B

车载用 工作温度125°C
SPI 串行E²PROM

特点

- 工作电压范围
 - 读出时: 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 6.5 MHz (最大值)
- 写入时间
 - S-25A080A/160A/320A: 4.0 ms (最大值)
 - S-25A080B/160B/320B: 5.0 ms (最大值)
- 支持 SPI 模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 32 节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS 施密特输入 (CS, SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数¹
 - S-25A080A/160A/320A: 10⁵次 / 字² (Ta = +25°C)
 - 5 × 10⁵次 / 字² (Ta = +125°C)
 - S-25A080B/160B/320B: 10⁵次 / 字² (Ta = +25°C)
 - 3 × 10⁵次 / 字² (Ta = +125°C)
- 数据保存期: 100 年 (Ta = +25°C)
- 50 年 (Ta = +125°C)
- 存储器容量
 - S-25A080A, S-25A080B: 8 K 位
 - S-25A160A, S-25A160B: 16 K 位
 - S-25A320A, S-25A320B: 32 K 位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 老化测试规格: 晶元级老化测试
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素³
- 应对 AEC-Q100 标准⁴

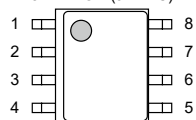
*1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。

*2. 每个地址 (字: 8 位)

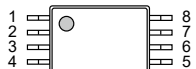
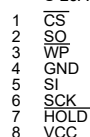
*3. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。

*4. 详情请与本公司营业部门联系。

8-Pin SOP (JEDEC)

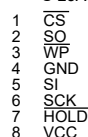


S-25A080A/160A/320A,
S-25A080B/160B/320B

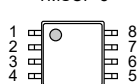


8-Pin TSSOP

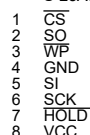
S-25A080A/160A,
S-25A080B/160B/320B



TMSOP-8



S-25A080B/160B/320B



S-25A640A, S-25A640B

车载用 工作温度125°C
SPI 串行E²PROM

特点

- 工作电压范围
 - 读出时: 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率
 - S-25A640A: 5.0 MHz (最大值)
 - S-25A640B: 6.5 MHz (最大值)
- 写入时间
 - S-25A640A: 4.0 ms (最大值)
 - S-25A640B: 5.0 ms (最大值)
- 支持 SPI 模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 32 节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS 施密特输入 (CS, SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数¹
 - S-25A640A: 10⁶次 / 字² (Ta = +25°C)
 - 5 × 10⁵次 / 字² (Ta = +125°C)
 - S-25A640B: 10⁶次 / 字² (Ta = +25°C)
 - 3 × 10⁵次 / 字² (Ta = +125°C)
- 数据保存期: 100 年 (Ta = +25°C)
- 50 年 (Ta = +125°C)
- 64 K 位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 老化测试规格: 晶元级老化测试
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素³
- 应对 AEC-Q100 标准⁴

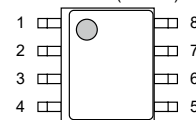
*1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。

*2. 每个地址 (字: 8 位)

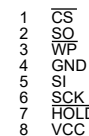
*3. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。

*4. 详情请与本公司营业部门联系。

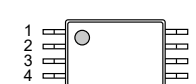
8-Pin SOP (JEDEC)



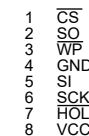
S-25A640A/B



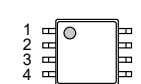
8-Pin TSSOP



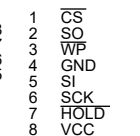
S-25A640B



TMSOP-8



S-25A640B



S-25A128B

车载用 工作温度125°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

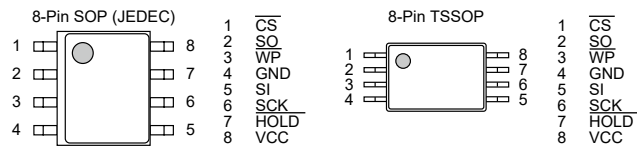
- 工作电压范围
 - 读出时: 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 6.5 MHz (最大值)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 支持 SPI 模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 64 节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS 施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数^{*1}:
 - 10⁶ 次 / 字^{*2} (Ta = +25 C)
 - 3 × 10⁵ 次 / 字^{*2} (Ta = +125 C)
- 数据保存期:
 - 100 年 (Ta = +25 C)
 - 50 年 (Ta = +125 C)
- 存储器容量: 128 K 位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 老化测试规格: 晶元级老化测试
- 工作温度范围: Ta = -40 C ~ +125 C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*3}
- 应对 AEC-Q100 标准^{*4}

*1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。

*2. 每个地址 (字 : 8 位)

*3. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。

*4. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25A256B

车载用 工作温度125°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

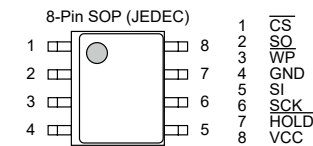
- 工作电压范围
 - 读出时: 2.5 V ~ 5.5 V
 - 写入时: 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 5.0 MHz (最大值)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 支持 SPI 模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 64 节 / 页
- 顺序读出功能
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS 施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数^{*1}:
 - 10⁶ 次 / 字^{*2} (Ta = +25 C)
 - 3 × 10⁵ 次 / 字^{*2} (Ta = +125 C)
- 数据保存期:
 - 100 年 (Ta = +25 C)
 - 50 年 (Ta = +125 C)
- 存储器容量: 256 K 位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 老化测试规格: 晶元级老化测试
- 工作温度范围: Ta = -40 C ~ +125 C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素^{*3}
- 应对 AEC-Q100 标准^{*4}

*1. 详情请参阅 "■ 重写次数"。

*2. 每个地址 (字 : 8 位)

*3. 详情请参阅 "■ 产品型号的构成"。

*4. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25C010A/020A/040A H系列

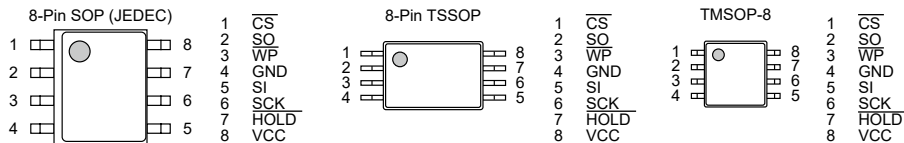
车载用 工作温度105°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 6.5 MHz (4.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间: 4.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 16字节/页
- 顺序读出功能
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时禁止写入功能
- CMOS施密特输入 ($\overline{\text{CS}}$, SCK, SI, $\overline{\text{WP}}$, $\overline{\text{HOLD}}$)
- 重写次数: 10^6 次/字^{*1} (Ta = +85°C)
 8×10^5 次/字^{*1} (Ta = +105°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +105°C)
- 存储器容量: S-25C010A 1K位
S-25C020A 2K位
S-25C040A 4K位
- 首次出厂时数据: FFh, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +105°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字: 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25C080A H系列

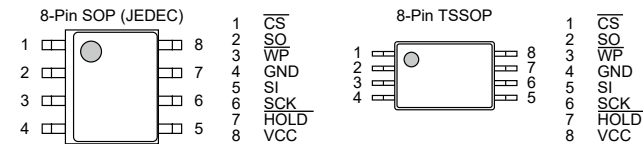
车载用 工作温度105°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 6.5 MHz (4.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间: 4.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 32字节/页
- 顺序读出功能
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 ($\overline{\text{CS}}$, SCK, SI, $\overline{\text{WP}}$, $\overline{\text{HOLD}}$)
- 重写次数: 10^6 次/字^{*1} (Ta = +85°C)
 8×10^5 次/字^{*1} (Ta = +105°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
50年 (Ta = +105°C)
- 存储器容量: 8 K位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +105°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字: 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25C160A H系列

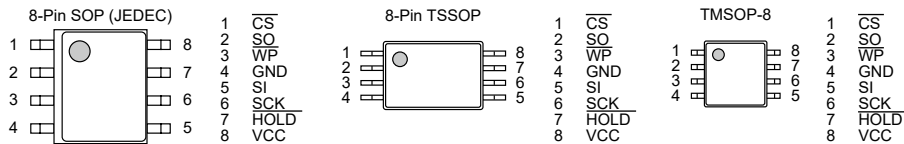
车载用 工作温度105°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 5.0 MHz (2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 32字节/页
- 顺序读出功能
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 写入保护功能: 软件、硬件
保护领域: 25%, 50%, 100%
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数: 10^6 次/字^{*1} (Ta = +25 C)
 3×10^5 次/字^{*1} (Ta = +85 C)
 2×10^5 次/字^{*1} (Ta = +105 C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25 C)
30年 (Ta = +85 C)
25年 (Ta = +105 C)
- 存储器容量: 16 K位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围: Ta = -40 C ~ +105 C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字: 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25C320A/640A H系列

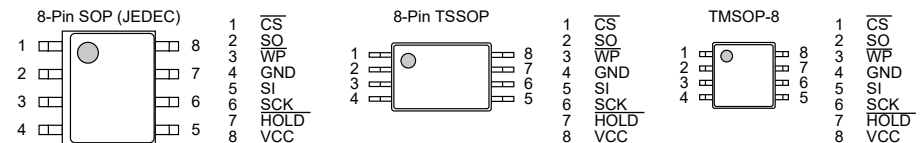
车载用 工作温度105°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 5.0 MHz (2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 32字节/页
- 顺序读出功能
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 写入保护功能: 软件、硬件
保护领域: 25%, 50%, 100%
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 (\overline{CS} , SCK, SI, \overline{WP} , \overline{HOLD})
- 重写次数: 10^6 次/字^{*1} (Ta = +25 C)
 3×10^5 次/字^{*1} (Ta = +85 C)
 2×10^5 次/字^{*1} (Ta = +105 C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25 C)
30年 (Ta = +85 C)
25年 (Ta = +105 C)
- 存储器容量: S-25C320A 32 K位
S-25C640A 64 K位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围: Ta = -40 C ~ +105 C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字: 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-25C128A H系列

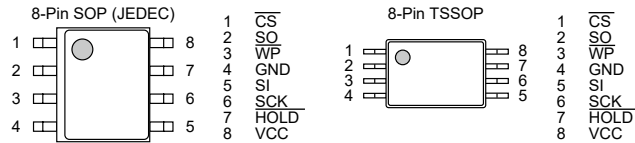
车载用 工作温度105°C
SPI 串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 工作频率: 5.0 MHz (2.5 V ~ 5.5 V)
- 写入时间: 5.0 ms (最大值)
- 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1)
- 页写入功能: 64字节/页
- 顺序读出功能
- 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
- 写入保护功能: 软件、硬件
- 保护领域: 25%, 50%, 100%
- 通过监视时钟脉冲防止误工作的功能
- 电源电压低时的禁止写入功能
- CMOS施密特输入 ($\overline{\text{CS}}$, SCK, SI, $\overline{\text{WP}}$, $\overline{\text{HOLD}}$)
- 重写次数: 10^6 次/字*1 (Ta = +25°C)
 3×10^5 次/字*1 (Ta = +85°C)
 2×10^5 次/字*1 (Ta = +105°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
30年 (Ta = +85°C)
25年 (Ta = +105°C)
- 存储器容量: 128 K位
- 首次出厂时数据: FFh, SRWD = 0, BP1 = 0, BP0 = 0
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +105°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*2

*1. 每个地址 (字: 8位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



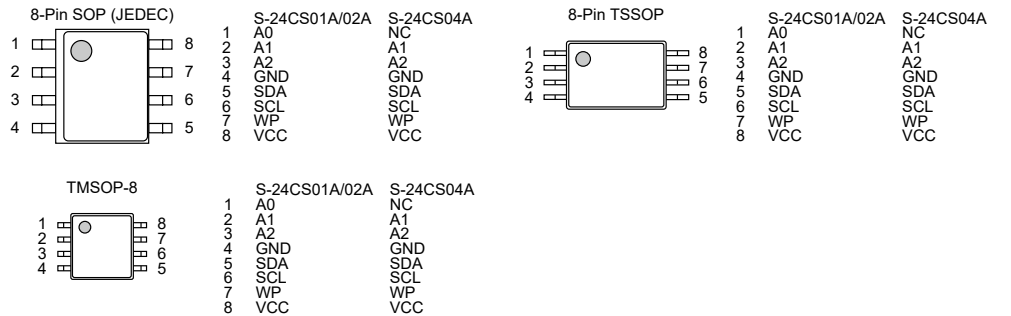
S-24CS01A/02A/04A H系列

车载用 工作温度105°C
2线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围: 读出时 2.55 V ~ 5.5 V (Ta = -40°C ~ +105°C)
写入时 2.55 V ~ 5.5 V (Ta = -40°C ~ +105°C)
- 页写入功能: 8字节/页 (S-24CS01A/02A)
16字节/页 (S-24CS04A)
- 顺序读出功能
- 工作频率: 400 kHz (V_{CC} = 2.55 V ~ 5.5 V, Ta = -40°C ~ +85°C)
350 kHz (V_{CC} = 2.55 V ~ 5.5 V, Ta = +85°C ~ +105°C)
- 写入时间: 10.0 ms (最大值)
- 电源电压低时禁止写入功能
- 重写次数: 10^6 次/字*1 (Ta = +85°C)
 5×10^5 次/字*1 (Ta = +105°C)
- 数据保存期: 100年 (Ta = +25°C)
20年 (Ta = +105°C)
- 存储器容量: S-24CS01A 1 K位
S-24CS02A 2 K位
S-24CS04A 4 K位
- 备有写入保护功能: 100%
- 首次出厂时数据: FFh
- 工作温度范围: Ta = -40°C ~ +105°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 每个地址 (字: 8位)



S-24C08C H系列

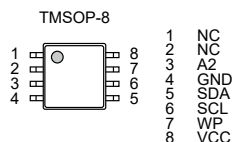
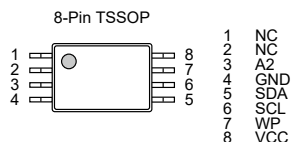
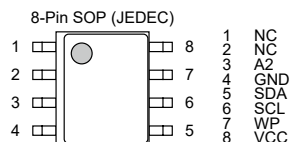
车载用 工作温度105°C
2线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 页写入功能 : 16字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25 C$)
 3×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +85 C$)
 2×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +105 C$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25 C$)
30年 ($T_a = +85 C$)
25年 ($T_a = +105 C$)
- 存储器容量 : 8 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂时数据 : FFh
- 工作温度范围 : $T_a = -40 C \sim +105 C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-24C16C H系列

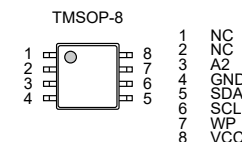
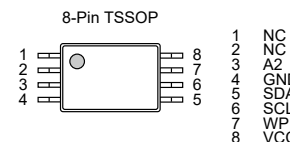
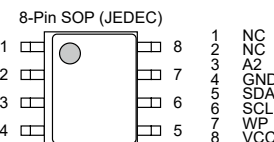
车载用 工作温度105°C
2线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 页写入功能 : 16字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25 C$)
 3×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +85 C$)
 2×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +105 C$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25 C$)
30年 ($T_a = +85 C$)
25年 ($T_a = +105 C$)
- 存储器容量 : 16 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂时数据 : FFh
- 工作温度范围 : $T_a = -40 C \sim +105 C$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-24C32C/64C H系列

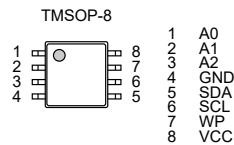
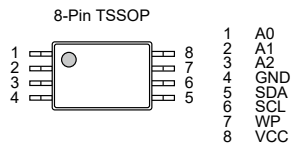
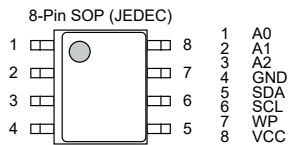
车载用 工作温度105°C
2线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 页写入功能 : 32字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
 3×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +85\text{ C}$)
 2×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +105\text{ C}$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
30年 ($T_a = +85\text{ C}$)
25年 ($T_a = +105\text{ C}$)
- 存储器容量 : S-24C32C 32 K位
S-24C64C 64 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂时数据 : FFh
- 工作温度范围 : $T_a = -40\text{ C} \sim +105\text{ C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-24C128C H系列

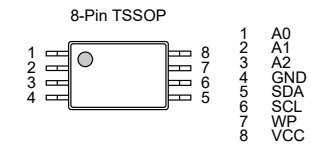
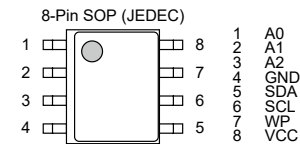
车载用 工作温度105°C
2线串行E²PROM

● 特点

- 工作电压范围 : 读出时 2.5 V ~ 5.5 V
写入时 2.5 V ~ 5.5 V
- 页写入功能 : 64字节 / 页
- 顺序读出功能
- 工作频率 : 400 kHz ($V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$)
- 写入时间 : 5.0 ms (最大值)
- 噪声除去 : 备有施密特触发器、噪声滤波器输入端子 (SCL, SDA)
- 低电源电压时禁止写入功能
- 重写次数 : 10^6 次 / 字^{*1} ($T_a = +25\text{ C}$)
 3×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +85\text{ C}$)
 2×10^5 次 / 字^{*1} ($T_a = +105\text{ C}$)
- 数据保存期 : 100年 ($T_a = +25\text{ C}$)
30年 ($T_a = +85\text{ C}$)
25年 ($T_a = +105\text{ C}$)
- 存储器容量 : 128 K位
- 备有写入保护功能 : 100%
- 首次出厂时数据 : FFh
- 工作温度范围 : $T_a = -40\text{ C} \sim +105\text{ C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 每个地址 (字 : 8 位)

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-57GD S系列

车载用、工作温度150°C、
高耐压、高速、
两极检测型霍尔效应开关IC

● 特点

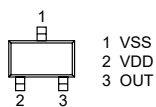
- 极性检测 : 检测两极
- 输出逻辑*1 : 动态 "L"
动态 "H"
- 输出方式*1 : N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值))
- 磁性灵敏度*1 : $B_{OP} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 10.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 15.0 \text{ mT}$ (典型值)
- 斩波频率 : $f_c = 500 \text{ kHz}$ (典型值)
- 输出延迟时间 : $t_D = 16.0 \mu\text{s}$ (典型值)
- 电源电压范围*2 : $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 26.0 \text{ V}$
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*3

*1. 可以选项。

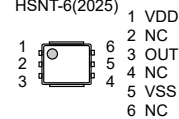
*2. 输出方式为N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值)) 时, $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}$ 。

*3. 详情请与代理商联系。

TSOT-23-3S



HSNT-6(2025)



S-57GS/GN S系列

车载用、工作温度150°C、
高耐压、高速、
单极检测型霍尔开关IC

● 特点

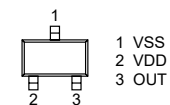
- 极性检测 : 单极检测
- 输出逻辑*1 : 动态 "L"
动态 "H"
- 输出方式*1 : N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值))
- 磁性灵敏度*1 : $B_{OP} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 10.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 15.0 \text{ mT}$ (典型值)
- 斩波频率 : $f_c = 500 \text{ kHz}$ (典型值)
- 输出延迟时间 : $t_D = 8.0 \mu\text{s}$ (典型值)
- 电源电压范围*2 : $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 26.0 \text{ V}$
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*3

*1. 可以选项。

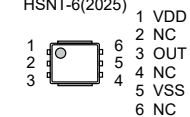
*2. 输出方式为N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值)) 时, $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}$ 。

*3. 详情请与代理商联系。

TSOT-23-3S



HSNT-6(2025)



S-57A1 A系列

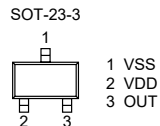
车载用 工作温度125°C 高耐压 高速
单极检测型 霍尔效应开关IC

● 特点

- 极性检测^{*1}: 检测S极
检测N极
- 输出逻辑^{*1}: 动态 "L"
动态 "H"
- 输出方式^{*1}: N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻
- 磁性灵敏度^{*1}: $B_{OP} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{OP} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值)
- 斩波频率: $f_C = 250 \text{ kHz}$ (典型值)
- 输出延迟时间: $t_D = 16.0 \mu\text{s}$ (典型值)
- 电源电压范围: $V_{DD} = 3.5 \text{ V} \sim 26.0 \text{ V}$
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围: $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*2}

*1. 可以选项。

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-57TZ S系列

车载用、工作温度150°C、
高耐压、高速、
Zero Crossing Latch霍尔效应IC

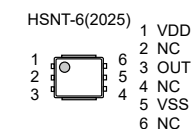
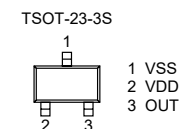
● 特点

- 极性检测: Zero Crossing Latch检测
- 输出逻辑^{*1}: 检测S极时 $V_{OUT} = "L"$
检测S极时 $V_{OUT} = "H"$
- 输出方式^{*1}: N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值))
- 零交叉锁存点: $B_Z = 0.0 \text{ mT}$ (典型值)
- 解除点 (S极)^{*1}: $B_{RS} = 3.0 \text{ mT}$ (典型值)
 $B_{RS} = 6.0 \text{ mT}$ (典型值)
- 斩波频率: $f_C = 500 \text{ kHz}$ (典型值)
- 输出延迟时间: $t_D = 8.0 \mu\text{s}$ (典型值)
- 电源电压范围^{*2}: $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 26.0 \text{ V}$
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围: $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准^{*3}

*1. 可以选项。

*2. 输出方式为N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值)) 时, $V_{DD} = 2.7 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}$ 。

*3. 详情请与代理商联系。



S-57RB S系列

车载用、工作温度150°C、
高耐压、高速、
交变检测型霍尔效应IC

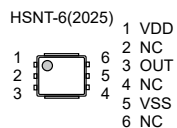
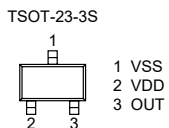
● 特点

- 极性检测 : 交变检测
- 输出逻辑*1 : 检测S极时V_{OUT} = "L"
检测S极时V_{OUT} = "H"
- 输出方式*1 : N沟道开路漏极输出
N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值))
- 磁性灵敏度*1 : B_{OP} = 0.5 mT (典型值)
B_{OP} = 2.2 mT (典型值)
B_{OP} = 3.0 mT (典型值)
B_{OP} = 6.0 mT (典型值)
B_{OP} = 10.0 mT (典型值)
- 斩波频率 : f_C = 500 kHz (典型值)
- 输出延迟时间 : t_D = 8.0 μs (典型值)
- 电源电压范围*2 : V_{DD} = 2.7 V ~ 26.0 V
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +150°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*3

*1. 可以选项。

*2. 输出方式为N沟道驱动器 + 内置上拉电阻 (1.2 kΩ (典型值)) 时, V_{DD} = 2.7 V ~ 5.5 V。

*3. 详情请与代理商联系。



S-57P1 S系列

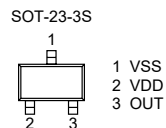
车载用 工作温度150°C 高耐压 高速
交变检测型 霍尔效应IC

● 特点

- 极性检测 : 交变检测
- 输出逻辑*1 : 检测S极时V_{OUT} = "L"
检测S极时V_{OUT} = "H"
- 输出方式 : N沟道开路漏极输出
- 磁性灵敏度*1 : B_{OP} = 0.5 mT (典型值)
B_{OP} = 1.5 mT (典型值)
B_{OP} = 2.2 mT (典型值)
B_{OP} = 3.0 mT (典型值)
- 斩波频率 : f_C = 500 kHz (典型值)
- 输出延迟时间 : t_D = 8.0 μs (典型值)
- 电源电压范围 : V_{DD} = 2.7 V ~ 26.0 V
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +150°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*2

*1. 可以选项。

*2. 详情请与本公司营业部门联系。



S-57K1 A系列

车载用 工作温度125°C 高耐压 高速
 交变检测型 霍尔效应IC

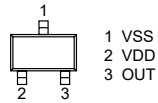
● 特点

- 极性检测 : 交变检测
- 输出逻辑*1 : 检测S极时V_{OUT} = "L"
 检测N极时V_{OUT} = "H"
- 输出方式*1 : N沟道开路漏极输出
 N沟道驱动器 + 内置上拉电阻
- 磁性灵敏度*1 : B_{OP} = 3.0 mT (典型值)
 B_{OP} = 6.0 mT (典型值)
- 斩波频率 : f_C = 500 kHz (典型值)
- 输出延迟时间 : t_D = 8.0 μs (典型值)
- 电源电压范围 : V_{DD} = 3.5 V ~ 26.0 V
- 内置稳压器
- 内置反向连接保护电路
- 内置输出电流限制电路
- 工作温度范围 : Ta = -40°C ~ +125°C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*2

*1. 可以选项。

*2. 详情请与本公司营业部门联系。

SOT-23-3



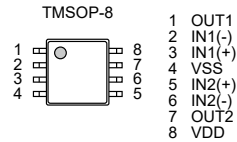
S-19610A

车载用、工作温度125°C 2电路 CMOS运算放大器

● 特点

- 输入失调电压低： $V_{IO} = +6.0 \text{ mV}$ (最大值) ($T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)
- 工作电源电压范围： $V_{DD} = 2.70 \text{ V} \sim 5.50 \text{ V}$
- 消耗电流低 (1个电路)： $I_{DD} = 1.00 \text{ mA}$ (典型值)
- 有内部相位补偿：不需外接器元件
- 工作温度范围： $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 应对AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与本公司营业部门联系。



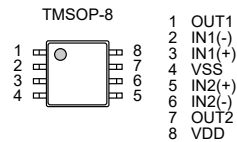
S-19611A

车载用、工作温度105°C、
2电路
低输入失调电压的CMOS运算放大器

● 特点

- 输入失调电压低： $V_{IO} = +17 \mu\text{V}$ (最大值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
 $V_{IO} = +100 \mu\text{V}$ (最大值) ($T_a = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$)
- 工作电源电压范围： $V_{DD} = 2.65 \text{ V} \sim 5.50 \text{ V}$
- 消耗电流低 (1个电路)： $I_{DD} = 200 \mu\text{A}$ (典型值)
- 有内部相位补偿：不需外接器元件
- Rail-to-Rail的输入与输出
- 工作温度范围： $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与代理商联系。



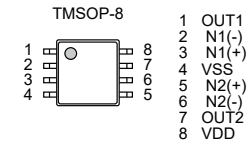
S-19630A

车载用、工作温度125°C、
2电路
低输入失调电压的CMOS运算放大器

● 特点

- 输入失调电压低： $V_{IO} = +50 \mu\text{V}$ (最大值) ($T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)
- 输入失调电压温漂低： $\frac{\Delta V_{IO}}{\Delta T_a} = \pm 25 \text{ nV}/^\circ\text{C}$ (典型值) ($V_{DD} = 30.0 \text{ V}$, $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$)
- 工作电源电压范围： $V_{DD} = 4.0 \text{ V} \sim 36.0 \text{ V}$
- 消耗电流低 (1个电路)： $I_{DD} = 250 \mu\text{A}$ (典型值)
- 输入噪声电压低： $V_{\text{NOISE_pp}} = 0.8 \mu\text{Vpp}$ (典型值) ($f = 0.1 \text{ Hz} \sim 10 \text{ Hz}$)
- 输入噪声电压密度低： $V_{\text{NOISE}} = 25 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (典型值) ($f = 1 \text{ kHz}$)
- 内置输出电流限制电路：限制输出端子短路时的过电流
- 有内部相位补偿：不需外接器元件
- Rail-to-Rail的输入与输出
- 工作温度范围： $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与代理商联系。



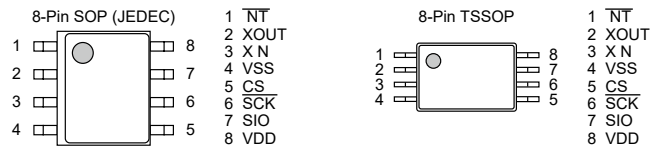
S-35190A H系列

车载用 工作温度105°C
3线 实时时钟

● 特点

- 低消耗电流 : 0.25 μ A (典型值) ($V_{DD} = 3.0$ V, $T_a = +25$ C)
- 宽工作电压范围 : 1.3 V ~ 5.5 V
- 内置时钟校正功能
- 内置用户自由寄存器
- 3线 (微型线路) 方式的CPU接口
- 内置报警中断器
- 内置低电源电压检测及电源接通时的标记生成电路
- 内置到2099年为止的自动日历, 闰年自动运算功能
- 内置稳压电路
- 内置32.768 kHz晶振电路 (内置 C_d 、外接 C_g)
- 工作温度范围 : $T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 应对AEC-Q100标准^{*1}

*1. 详情请与本公司营业部门联系。



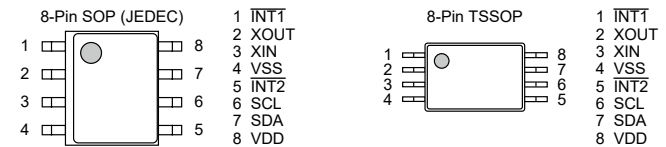
S-35390A H系列

车载用 工作温度105°C
2线 实时时钟

● 特点

- 低消耗电流 : 0.25 μ A (典型值) ($V_{DD} = 3.0$ V, $T_a = +25$ C)
- 宽工作电压范围 : 1.3 V ~ 5.5 V
- 内置时钟校正功能
- 内置用户自由寄存器
- 2线 (I²C-bus) 方式的CPU接口
- 内置报警中断器
- 内置低电源电压检测及电源接通时的标记生成电路
- 内置到2099年为止的自动日历, 闰年自动运算功能
- 内置稳压电路
- 内置32.768 kHz晶振电路 (内置 C_d 、外接 C_g)
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 工作温度范围 : $T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 应对AEC-Q100标准^{*1}

*1. 详情请与本公司营业部门联系。



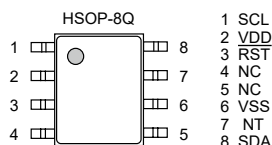
S-35710M A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
内置水晶振子的2线定时器

特点

- 内置32.768 kHz水晶振子 : 1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位来进行设置
- 报警中断功能 : 0.25 μ A (典型值) ($V_{DD} = 3.0$ V、 $T_a = +25^\circ$ C)
- 低消耗电流: 1.8 V ~ 5.5 V
- 宽工作电压范围 : $T_a = -40^\circ$ C ~ $+125^\circ$ C
- 2线 (I²C-bus) 方式的CPU接口
- 工作温度范围 :
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100/Q200标准*1

*1. 详情请与代理商联系。



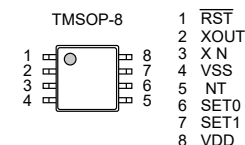
S-35720 A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
带中断时间设定端子的定时器

特点

- 报警中断功能 : 可设置中断时间 1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位选择选项
- 低消耗电流 : 0.2 μ A (典型值) (水晶振子 : $C_L = 6.0$ pF、 $V_{DD} = 3.0$ V、 $T_a = +25^\circ$ C)
- 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 内置32.768 kHz晶振电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ$ C ~ $+125^\circ$ C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与代理商联系。



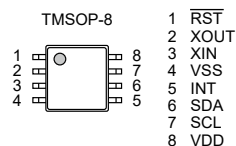
S-35710 A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
2线定时器

特点

- 报警中断功能 : 1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位来进行设置
- 低消耗电流: 0.2 μ A (典型值) (水晶振子 : $C_L = 6.0$ pF、 $V_{DD} = 3.0$ V、 $T_a = +25^\circ$ C)
- 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 2线 (I²C-bus) 方式的CPU接口
- 内置32.768 kHz晶振电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ$ C ~ $+125^\circ$ C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与代理商联系。



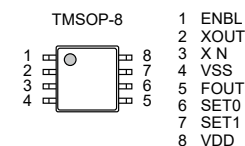
S-35730 A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
有时钟脉冲输出功能、带频率设定端子的定时器

特点

- 时钟脉冲输出功能 : 可设定时钟脉冲频率、带输出控制端子
- 低消耗电流 : 0.7 μ A (典型值) (水晶振子 : $C_L = 6.0$ pF、 $V_{DD} = 3.0$ V、ENBL端子 = "H"、 $T_a = +25^\circ$ C、FOUT端子 = N沟道漏极输出)
- 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 内置32.768 kHz晶振电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ$ C ~ $+125^\circ$ C
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与本公司营业部门联系。



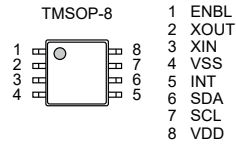
S-35740 A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
2线间隔定时器

● 特点

- 固定周期中断信号输出功能 : 可设定频率和占空比, 带输出控制端子
- 低消耗电流 : 0.2 μA (典型值) (水晶振子: $C_L = 6.0 \text{ pF}$ 、 $V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ 、ENBL端子 = "H"、 $T_a = +25^\circ\text{C}$)
- 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V
- 2线 (I²C-bus) 方式的CPU接口
- 内置32.768 kHz晶振电路
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

*1. 详情请与本公司营业部门联系。



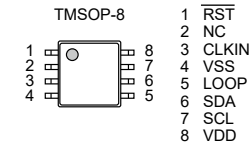
S-35770 A系列

便利型定时器
车载用、工作温度125°C、
2线计数器

● 特点

- 外部时钟信号计数功能 : 可在0 ~ 16,777,215的范围内计数, 并带计数器一个巡回标记输出端子
- 低消耗电流 : 0.01 μA (典型值) ($V_{DD} = 3.0 \text{ V}$ 、 $T_a = +25^\circ\text{C}$ 、非通信时 (CLKIN端子= 0 V))
- 宽工作电压范围 : 1.5 V ~ 5.5 V
- 2线 (I²C-bus) 方式的CPU接口
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 符合AEC-Q100标准*1

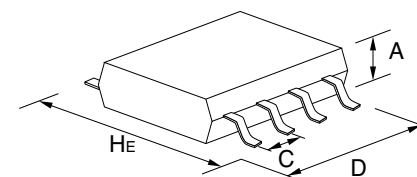
*1. 详情请与本公司营业部门联系。



封装类型	引脚数	封装名称	封装尺寸 (mm)			间距 (mm)
			He	D	A (max.)	C
引线插入型	3	TO-92	7.0	5.2	4.2	2.5/1.27
	3	TO-92S	4.95	4.1	1.62	2.5/1.27
扁平引线型	3	SOT-89-3	4.0	4.5	1.6	1.5
	5	SOT-89-5	4.5	4.5	1.6	1.5
双翅型	4	SC-82AB	2.1	2.0	1.1	1.3
	5	SC-88A	2.1	2.0	1.1	0.65
	3	SOT-23-3	2.8	2.9	1.3	1.9
	3	SOT-23-3S	2.8	2.9	1.2	1.9
	3	TSOT-23-3S	2.85	2.9	0.8	1.9
	5	SOT-23-5	2.8	2.9	1.3	0.95
	6	SOT-23-6	2.8	2.9	1.35	0.95
	6	SOT-23-6W	2.8	2.9	1.3	0.95
	8	8-Pin SOP (JEDEC)	6.0	5.02	1.75	1.27
	8	8-Pin TSSOP	6.4	3.0	1.1	0.65
	8	8-Pin TSSOP	6.4	3.0	1.1	0.65
	16	16-Pin TSSOP	6.4	5.1	1.1	0.65
	20	20-Pin TSSOP	6.4	6.5	1.2	0.65
	24	24-Pin SSOP	7.6	7.9	1.4	0.65
	8	TMSOP-8	4.0	2.9	0.8	0.65
	8	HTMSOP-8	4.0	2.9	0.8	0.65
	16	HTSSOP-16	6.4	5.12	1.1	0.65
	6	HSOP-6	6.0	5.02	1.75	1.91
	8	HSOP-8A	6.0	5.02	1.68	1.27
	8	HSOP-8A	6.0	5.02	1.65	1.27
	8	HSOP-8Q	6.0	5.02	1.68	1.27
	5	TO-252-5S(A)	6.5	6.5	1.4	1.27
	9	TO-252-9S	6.5	6.5	1.4	0.65

封装类型	引脚数	封装名称	封装尺寸 (mm)			间距 (mm)
			He	D	A (max.)	C
无引线型	6	6-Pin HSON(A)	3.0	2.9	0.9	0.95
	6	SON-6C	2.55	1.56	0.65	0.5
	4	SNT-4A	1.6	1.2	0.5	0.65
	6	SNT-6A SNT-6A(H)	1.8	1.57	0.5	0.5
	8	SNT-8A	2.46	1.97	0.5	0.5
	4	HSNT-4(0808)	0.8	0.8	0.4	0.4
	4	HSNT-4(0808)B	0.8	0.8	0.41	0.4
	4	HSNT-4(1010)	1.0	1.0	0.4	0.65
	4	HSNT-4(1010)B	1.0	1.0	0.41	0.65
	6	HSNT-6A	2.46	1.96	0.5	0.5
	6	HSNT-6(1212)	1.2	1.2	0.4	0.4
	6	HSNT-6D (HSNT-6(1618))	1.8	1.6	0.4	0.5
	6	HSNT-6(2025)	2.46	1.96	0.5	0.5
	8	HSNT-8(1616)	1.6	1.6	0.4	0.4
	8	HSNT-8(2030)	3.0	2.0	0.5	0.5
	6	DFN-6(1414)A	1.4	1.4	0.6	0.5
	6	DFN-6(1518)A	1.8	1.5	0.33	0.5
	8	DFN-8(1616)A	1.6	1.6	0.6	0.4
	8	DFN-8(2030)	3.0	2.0	0.5	0.5
	8	DFN-8(2030)A	3.0	2.0	0.6	0.5
8	DFN-8(2030)B	3.0	2.0	0.8	0.5	

备注 有关详细的WLP封装产品, 请向代理商咨询。



注意事项

- 本产品目录有可能未经预告而更改内容。
- 未经本公司许可，严禁将本产品目录的一部分或全部内容进行转载、复制等来用于其他目的。
- 本产品目录所登载的产品照片由于是印刷品，与实际产品相比，色彩可能稍有偏差。使用时请事先确认。
- 本产品目录上所登载的电路和使用方法仅供参考。对因这些资料所引起的对第三者的权利（包括知识产权）的侵犯或损害，本公司不予以任何保证。另外，本产品目录并非是对第三者或本公司的知识产权的实施权的许可。
- 本产品目录所登载产品，如果属于“外汇及外国贸易法”所规定的限制货物（或劳务），则必须取得该法规所规定的出口许可。
- 本产品目录所登载的产品未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械及核电关联器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 本产品目录所记载的产品，非耐放射线设计产品。
- 本公司已为提高品质、可靠性作了最大的努力，但是半导体产品有可能按照一定的概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误工作而产生的人身事故、火灾事故和社会损害等，请用户在安全设计上予以足够的重视，采取诸如冗余设计、延烧对策设计和防止错误工作设计等措施。



更小型。更节能。更安全方便。

具备以钟表制造业培育的低消耗电流、低电压工作和超小型封装技术。拥有满足严格的车载基准、高质量及高信赖性的精湛工艺。艾普凌科有限公司的半导体解决方案为世界带来超越客户及社会期待的感动。



艾普凌科有限公司

www.ablic.com

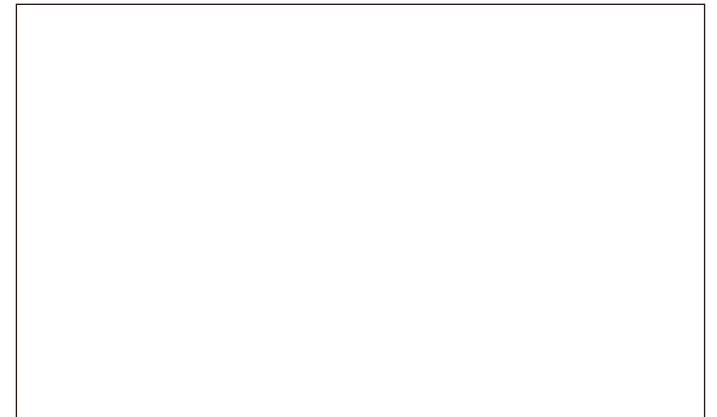
咨询处

www.ablic.com/en/semicon/sales/



2023年3月发行

艾普凌科有限公司是美蓓亚三美株式会社集团公司的成员。



本目录内容在改进产品时，有可能未经预告而有所更改。